Содержание

• *Электронные свойства полупроводников*

Степанов Н.П., Иванов М.С.

Особенности в поведении температурных зависимостей магнитной восприимчивости кристаллов твердых растворов $Bi_2Te_3-Sb_2Te_3$, содержащих от 25 до 70% теллурида сурьмы 1103

• *Поверхность, границы раздела, тонкие пленки*

Логинов А.Б., Бокова-Сирош С.Н., Федотов П.В., Сапков И.В., Хмеленин Д.Н., Исмагилов Р.Р., Образцова Е.Д., Логинов Б.А., Образцов А.Н.

Получение и свойства мезопористых пленок MoS_2 1112

• *Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления*

Вознюк Г.В., Григоренко И.Н., Лила А.С., Митрофанов М.И., Николаев Д.Н., Евтихиев В.П.

О влиянии травления сфокусированным пучком ионов Ga^+ в диапазоне энергий 12–30 кэВ на люминесцентные свойства гетероструктуры $Al_{0.18}Ga_{0.82}As/GaAs/Al_{0.18}Ga_{0.82}As$. 1120

Бохан П.А., Журавлев К.С., Закревский Д.Э., Малин Т.В., Осинных И.В., Фатеев Н.В.

Стимулированная эмиссия в сильно легированных $Al_{0.68}Ga_{0.32}N:Si$-структурах с поперечной оптической накачкой при комнатной температуре 1125

• *Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники*

Морозов К.М., Белоновский А.В., Калитеевский М.А.

Анализ динамики затухания люминесценции в металл-диэлектрических фотонных структурах с органическими слоями 1132

• *Углеродные системы*

Елисеев И.А., Гущина Е.А., Клотченко С.А., Лебедев А.А., Лебедева Н.М., Лебедев С.П., Нащекин А.В., Петров В.Н., Пузык М.В., Роенков А.Д., Смирнов А.Н., Танклевская Е.М., Усиков А.С., Шабунина Е.И., Шмидт Н.М.

Изменение адсорбционных свойств графена в процессе получения биосенсоров вирусных инфекций 1137

• *Физика полупроводниковых приборов*

Корнышов Г.О., Гордеев Н.Ю., Шерняков Ю.М., Бекман А.А., Паюсов А.С., Минтаиров С.А., Калюжный Н.А., Максимов М.В.

Связь длины волны и усиления в лазерах на квантовых ямах, точках и яма-точках 1144

Паюсов А.С., Бекман А.А., Корнышов Г.О., Шерняков Ю.М., Максимов М.В., Гордеев Н.Ю.

Измерение теплового сопротивления торцевых полупроводниковых лазеров по спектрам спонтанного излучения 1148

Александров О.В.

Дисперсионный транспорт дырочных поляронов в МОП-структурах после ионизирующего излучения 1154

Учредители:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Российская академия наук
Ленинский пр., 14, Москва, 199000
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе
Российской академии наук
Политехническая ул., 26, Санкт-Петербург, 194021
Телефон: (812)297-2245. Факс: (812)297-1017
post@mail.ioffe.ru http://www.ioffe.ru

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации
Регистрационный номер ПИ № ФС77-71300 от 17 октября 2017 г.

Издатель: ФТИ им. А. Ф. Иоффе
194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26

Адрес редакции: 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26
semicond@mail.ioffe.ru
http://www.ioffe.ru/journals/ftp/

Зав. редакцией *С. Б. Короткова*

Компьютерный набор и изготовление оригинал-макета
ФТИ им. А. Ф. Иоффе
194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26

Подписано к печати 30.11.2022. Дата выхода в свет 30.12.2022.
Формат 60×90 1/8.
Усл. печ. л. 7.2. Уч.-изд. л. 6.9.
Тираж 45 экз.
Тип. зак. № 0000. Цена свободная.

Отпечатано с предоставленных готовых файлов
в полиграфическом центре ФГУП Издательство „Известия“
127254, Москва, ул. Добролюбова, 6
телефон: (495)650-3880, http://izv-udprf.ru